



⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENT- UND

MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**

DE 100 05 555 A 1

⑤ Int. Cl. 7:
B 81 B 3/00
B 81 C 1/00
// G01P 15/08

① Aktenzeichen: 100 05 555.9
② Anmeldetag: 9. 2. 2000
③ Offenlegungstag: 16. 8. 2001

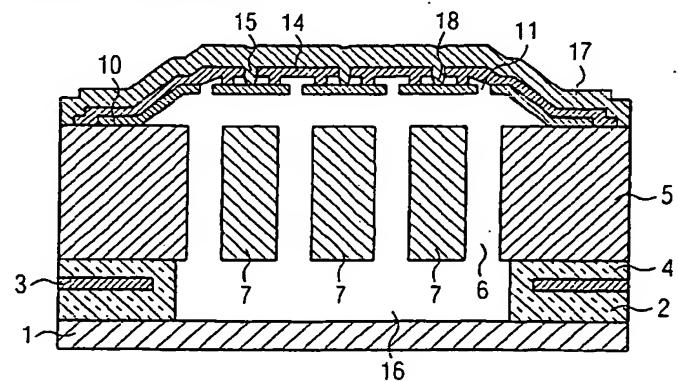
71 Anmelder:

⑦ Erfinder:

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

54 Mikromechanisches Bauelement und entsprechendes Herstellungsverfahren

57) Die Erfindung schafft ein mikromechanisches Bauelement mit einem Substrat (1); einem auf dem Substrat (1) vorgesehenen Funktionsbereich (5); und einer kappenförmigen Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14', 20, 25; 10'', 14'', 30) zum Abdecken des Funktionsbereichs (5). Die kappenförmige Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14', 20, 25; 10'', 14'', 30) weist mindestens eine obere und eine untere Deckschicht (10, 14; 10', 14'; 10'', 14'') auf. Die Deckschichten (10, 14; 10', 14'; 10'', 14'') weisen eine jeweilige zueinander versetzte Lochanordnung (11, 15) auf, von denen mindestens eine durch mindestens eine Verschlußschicht (17; 20, 25; 14'', 30) verschlossen ist.



DE 100 05 555 A 1

Beschreibung

STAND DER TECHNIK

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mikromechanisches Bauelement mit einem Substrat, einem auf dem Substrat vorgesehenen Funktionsbereich und einer kappenförmigen Abdeckung zum Abdecken des Funktionsbereichs sowie ein entsprechendes Herstellungsverfahren, wie aus der DE 195 37 814 A1 bekannt.

Obwohl auf beliebige mikromechanische Bauelemente und Strukturen, insbesondere Sensoren und Aktuatoren, anwendbar, werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrundeliegende Problematik in bezug auf ein in der Technologie der Silizium-Oberflächenmikromechanik herstellbares mikromechanisches Bauelement, z. B. einen Beschleunigungssensor, erläutert.

In der DE 195 37 814 A1 werden der Aufbau eines funktionalen Schichtsystems und ein Verfahren zur hermetischen Verkappung von Sensoren in Oberflächenmikromechanik beschrieben. Hierbei wird die Herstellung der Sensorstruktur mit bekannten technologischen Verfahren erläutert. Die besagte hermetische Verkappung erfolgt mit einem separaten Kappen-Wafer aus Silizium, der mit aufwendigen Strukturierungsprozessen, wie beispielsweise KHO-Ätzen, strukturiert wird. Der Kappen-Wafer wird mit einem Glas-Lot (Seal-Glas) auf dem Substrat mit dem Sensor (Sensor-Wafer) aufgebracht. Hierfür ist um jeden Sensorchip ein breiter Bond-Rahmen notwendig, um eine ausreichende Haftung und Dictheit der Kappe zu gewährleisten. Dies begrenzt die Anzahl der Sensor-Chips pro Sensor-Wafer erheblich. Auf Grund des großen Platzbedarfs und der aufwendigen Herstellung des Kappen-Wafers entfallen erhebliche Kosten auf die Sensor-Verkappung.

VORTEILE DER ERFINDUNG

Das erfindungsgemäße mikromechanische Bauelement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. das Herstellungsverfahren nach Anspruch 8 sieht einen mindestens zweischichtigen Schichtaufbau vor, mit dem mikromechanische Sensoren bzw. Funktionsstrukturen hermetisch verkappt werden können. Dabei lässt sich ein definierter Gas- und/oder Druckeinschluss gewährleisten.

Kern der Erfindung ist also eine Mehrschichtstruktur, die über mikromechanischen Sensoren bzw. Funktionsstrukturen abgeschieden wird und diese vor Umgebungseinflüssen schützt. Dabei wird die Sensorkappe nicht wie üblich separat durch Ätz-Prozesse strukturiert und mit einem Seal-Glas-Lötverfahren mit dem Sensor-Wafer bzw. Funktions-Wafer verbunden, sondern die Verkappung wird direkt auf dem Sensor-Wafer derart erzeugt, dass ein Mehrschichtgerüst über den beispielsweise beweglichen Funktionsstrukturen aufgebaut wird, wobei das Mehrschichtgerüst nach einem Opferschicht-Ätzen durch mindestens eine Verschlusschicht hermetisch verschlossen wird.

Hierdurch ist eine wesentlich kleinere kappenförmige Abdeckung als beim Stand der Technik möglich. Das Mehrschicht-Kappen-Gerüst lässt sich mit einfachen Halbleiterprozessen erzeugen. Es kann auf PbO-haltiges Seal-Glas verzichtet werden, welches unter Feuchtigkeitseinfluss eine massive Korrosion auf Al-Bond-Pads verursacht.

In den Unteransprüchen finden sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des in Anspruch 1 angegebenen mikromechanischen Bauelements.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist eine erste Verschlußschicht über der oberen Deckschicht angeordnet, und die Lochanordnung der oberen Deckschicht ist durch

die erste Verschlußschicht verpropft.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist eine zweite Verschlußschicht zwischen der oberen und der unteren Deckschicht angeordnet, und die Lochanordnung der oberen Deckschicht ist durch Schmelzperlen der zweiten Verschlußschicht verschlossen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung fungiert die obere Deckschicht als Verschlußschicht für die Lochanordnung der unteren Deckschicht. Dies lässt sich dadurch realisieren, daß das Material der oberen Deckschicht derart gewählt wird, daß es einen niedrigeren Schmelzpunkt als das Material der unteren Deckschicht aufweist und die obere Deckschicht aufgeschmolzen wird, so daß sie die Lochanordnung der unteren Deckschicht verschließt.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die obere Deckschicht Verbindungsstege zur Verbindung mit der unteren Deckschicht auf.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die untere Deckschicht und/oder die obere Deckschicht Polysilizium oder Aluminium auf.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Verschlußschicht Aluminium, Silizium, Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, ein Glas oder einen Lack auf.

ZEICHNUNGEN

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1a-g eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsritte eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 1h eine Draufsicht auf das mikromechanischen Bauelement gemäß der ersten Ausführungsform zur Illustration der verschiedenen Lochanordnungen;

Fig. 2a-e eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsritte eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 3a-c eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsritte eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugssymbole gleiche oder funktionsgleiche Komponenten.

Fig. 1a-g zeigen eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsritte eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und Fig. 1h eine entsprechende Draufsicht zur Illustration der verschiedenen Lochanordnungen.

Gemäß Fig. 1a werden, wie im Stand der Technik beschrieben, auf einem Silizium-Substrat 1 eine Opferschicht 2 aus SiO_2 , eine strukturierte Leiterbahnebene 3 und eine weitere Opferschicht 4 aus SiO_2 aufgebracht. Auf der Opferschicht 4 wird eine funktionale Schicht mit dem Funktionsbereich 5 aufgebracht, welche durch ebenfalls bekannte Verfahren für das Ätzen von Gräben 6 strukturiert wird. Beispielsweise kann dazu das in der DE 42 41 045 A1 beschriebene Verfahren eingesetzt werden. Die funktionale Strukturierung 7, welche hier beispielhaft als drei Elektrodenfinger dargestellt sind, werden für das vorgeschlagene Bauelement entweder durch ein bekanntes Verfahren zum Opferschicht-Ätzen frei beweglich gemacht (siehe z. B. die

DE 43 17 274 A1), oder sie bleiben nach dem Tiefen-Ätzen noch fest auf der Opferschicht 4 angebunden, wie dies in Abb. 1a dargestellt ist.

Wie in Fig. 1b dargestellt, wird auf den funktionalen Strukturelementen 7 des mikromechanischen Bauelements in einem nächsten Schritt eine dicke Opferschicht 8 derart abgeschieden, dass die Strukturgräben 6 teilweise im oberen Grabenbereich 9 mit dem Opfermaterial aufgefüllt sind. Die Opferschicht 8 deckt den Teil der Struktur ab, welcher im Endzustand verkappt sein soll. Die Opferschicht 8 hat vorzugsweise eine Dicke von 1 µm bis 20 µm und kann beispielsweise aus Siliziumdioxid, Bor-Phosphor-Silikat-Glas oder amorphen Silizium bestehen. Es kann aber auch jedes andere Material verwendet werden, das sich isotrop mit einer ausreichenden Selektivität gegenüber den funktionalen Strukturelementen 7 und den späteren Deckschichten ätzen lässt.

Als nächstes wird gemäß Fig. 1c auf die Opferschicht 8 die untere Deckschicht 10 abgeschieden und mit einer Lochanordnung mit kleinen Löchern 11 strukturiert. Die Löcher 11 können eckig oder rund sein. Der Durchmesser der Löcher 11 liegt vorzugsweise zwischen 0,5 µm und 20 µm. Die Lochnung wird so ausgelegt, dass sie gleichmäßig über der Fläche der funktionalen Strukturelemente 7 liegt. Die untere Deckschicht 10 ist vorzugsweise zwischen 0,5 µm und 10 µm dick und aus Polysilizium oder Aluminium hergestellt. Sie kann aber auch aus jedem anderen Material bestehen, das resistent gegen das Opferschicht-Ätzen der Opferschicht 8 und weiterer Opferschichten ist. Die untere Deckschicht 10 wird über den Rand der Opferschicht 8 hinausgezogen und an die Schicht mit den funktionalen Strukturelementen 7 angebunden. Die untere Deckschicht 10 steht idealerweise unter intrinsischer Zugspannung, die durch geeignete Temperaturbehandlung eingestellt werden kann.

Wie in Fig. 1d illustriert, wird auf der ersten Deckschicht 10 eine zweite Opferschicht 12 aufgebracht. Diese zweite Opferschicht 12 besteht idealerweise aus dem gleichen Material wie die erste Opferschicht 8, also aus Siliziumdioxid, und ist ebenfalls selektiv gegenüber der unteren Deckschicht 10 ätzbar. Die Dicke der zweiten Opferschicht 12 beträgt vorzugsweise zwischen 0,3 µm und 5 µm. Die zweite Opferschicht 12 wird danach derart strukturiert, dass sie auf der Durchgangslochanordnung 11 der unteren Deckschicht 10 liegt. Auch die zweite Opferschicht 12 weist eine Lochanordnung mit Löchern 13 auf, welche gegenüber den Löchern 11 der Lochanordnung der unteren Deckschicht 10 versetzt sind.

Gemäß Fig. 1e wird auf der zweiten Opferschicht 12 die obere Deckschicht 14 abgeschieden. Diese obere Deckschicht 14 ist lokal über die Löcher 13 der zweiten Opferschicht 12 an der unteren Deckschicht 10 angebunden. In der oberen Deckschicht 14 wird eine Lochanordnung mit Löchern 15 ausgebildet, wobei die Löcher 15 gegenüber den Löchern 11 der unteren Deckschicht 10 versetzt sind, so dass die Löcher 11 alle samt von der oberen Deckschicht 14 überdeckt werden und unter den Löchern 15 überall die untere Deckschicht 10 liegt. Die Lochnung besitzt vorzugsweise einen Durchmesser von 0,5 µm bis 20 µm. Die obere Deckschicht 14 wird über den Rand der zweiten Opferschicht 12 hinaus gezogen und an der unteren Deckschicht 10 und vorzugsweise auch an der Peripherie des Funktionsbereiches 5 angebunden. Mit anderen Worten überdeckt die obere Deckschicht 14 auch die untere Deckschicht 10 vorzugsweise vollständig. Die obere Deckschicht 14 ist zwischen 0,5 µm und 30 µm dick und kann wie die untere Deckschicht 10 beispielsweise aus Silizium oder Aluminium oder sonstigen Materialien mit den erforderlichen Ätz-Eigenschaften bestehen.

Wie in Fig. 1f bildlich dargestellt, werden danach in einem selektiven Ätzschritt die erste Opferschicht 8 und die zweite Opferschicht 12 geätzt. Hierbei kann eine nasschemische Verfahren, wie z. B. BOF (BOF = buffered oxide etch

= gepufferte Oxidätzung) oder ein Trockenätzverfahren, wie beispielsweise das aus der DE 43 17 274 A1 bekannte Flusssäure-Dampf-Ätzverfahren verwendet werden. Die Opferschichten 2 und 4 unterhalb der funktionalen Strukturelemente 7 können in diesem Schritt ebenfalls geätzt werden, falls nicht schon vor Abscheidung der ersten Opferschicht 8 geschehen. Nach diesem selektiven Ätzschritt ist über den funktionalen Strukturelementen (hier bewegliche Kondensatorelektroden) eine Kappe bzw. Kuppel aufgespannt, welche mit Löchern perforiert ist. Diese Kappe besteht aus den miteinander verbundenen Deckschichten 10, 14, wobei es keinen geradlinigen Weg für Gase bzw. Atome oder Moleküle durch die Kappe gibt, da die Lochanordnungen in den Deckschichten 10, 14 gegeneinander versetzt angeordnet sind.

In einem weiteren Schritt wird gemäß Fig. 1g eine Verschlusschicht 17 auf der oberen Deckschicht 14 vorgeschen, welche über Propfen 18 die Löcher 15 der oberen Deckschicht 14 dicht verschließt. Die Verschlusschicht 17 überdeckt vorzugsweise die obere Deckschicht 14 vollständig. Der Verschließvorgang erfolgt unter definierten Gas- und Druckverhältnissen. Die Verschlusschicht 17 kann aus Aluminium, Silizium, Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, einem Glas, einem Lack oder einem sonstigen geeigneten Material bestehen und wird vorzugsweise mittels eines CVD (Chemical Vapour Deposition)-Verfahrens, Sputterverfahren, Aufdampfverfahrens, Flashverdampfungsverfahren, Spin-On-Verfahrens oder Sprühverfahrens aufgebracht.

Damit ist die gezeigte Sensorstruktur hermetisch verkappt, und unter der Verkapping in dem Funktionsbereich 5 mit den funktionalen Strukturelementen herrschen eine vorbestimmte Atmosphäre und ein vorbestimmter Druck.

Fig. 1h illustriert die gegenseitige Orientierung der verschiedenen Lochnungen. In der Draufsicht von Fig. 1h wird der Versatz der Löcher 15 in der oberen Deckschicht 14 gegenüber den Löchern 11 in der unteren Deckschicht 10 deutlich. Die Verbindungsstellen 13 zwischen der unteren Deckschicht 10 und der oberen Deckschicht 14 sind gegenüber den beiden Lochanordnungen mit den Löchern 11 bzw. 15 versetzt, so dass Gase (z. B. Reaktionsprodukte und -edukte beim Opferschichtätzen) durch beide Lochanordnungen ins Freie strömen können.

Fig. 2a-e illustrieren eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsstufen eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Bei der zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen mikromechanischen Bauelementes wird, wie in Fig. 2a illustriert, auf die untere Deckschicht 10' eine Schicht 20 aufgebracht und strukturiert, welche bevorzugt aus Aluminium oder einem anderen schmelzbaren Material mit ausreichender Oberflächenspannung und geeigneter Haftung bzw. Benetzung auf dem Material der unteren Deckschicht 10' besteht. Die Schichtdicke der zweiten Verschlusschicht 20 sollte kleiner als die Dicke der zweiten Opferschicht 12' sein. Des Weiteren ist die zweite Verschlusschicht 20 derart strukturiert, dass sie die Löcher 11 der unteren Deckschicht 10 frei lässt und unterhalb der Löcher 15 der oberen Deckschicht 14' angeordnet ist.

Wie in Fig. 2b dargestellt, wird analog wie bei der ersten Ausführungsform die obere Opferschicht 12' abgeschieden und strukturiert. Allerdings enthält die zweite Opferschicht 12' bei dieser zweiten Ausführungsform nicht notwendigerweise Löcher zur Anbindung der oberen Deckschicht 14' an

der unteren Deckschicht 10'.

Gemäß Fig. 2c erfolgt das Opferschicht-Ätzen zum Ätzen der Schichten 2, 4, 8 und 12' im nächsten Prozessschritt. Nach dem Opferschicht-Ätzen ist ein Temperaturschritt zur thermischen Reinigung der Sensoroberflächen zweckmäßig, der jedoch nicht über die Schmelztemperatur des Materials der zweiten Verschlusschicht 20 reichen darf. Nach der Reinigung wird die gesamte Struktur in eine Heizvorrichtung eingebracht, in der definierte Gas- und Druckverhältnisse eingestellt werden können. Hierbei kann beispielsweise ein Vakuum erzeugt werden, oder ein Edelgas bzw. ein anderes Gas zur Erhöhung der Dämpfung der Schwingungen der funktionalen Strukturelemente 7 eingeschlossen werden.

Wie in Fig. 2d gezeigt, wird nach Einregelung der Gas- und Druckverhältnisse die Temperatur in der Heizvorrichtung über den Schmelzpunkt des Materials der zweiten Verschlusschicht 20 erhöht, so dass sich das Material 20 auf Grund der Oberflächenspannung zusammenzieht und Schmelzperlen ausbildet. Die Lage dieser Schmelzperlen auf der unteren Deckschicht 10 wird über die Strukturlage und Dicke der zweiten Verschlusschicht 20 derart gesteuert, dass die Schmelzperlen exakt unter den Löchern 15 der zweiten Deckschicht 14' entstehen. Das Material der zweiten Verschlusschicht 20 ist derart gewählt, dass es eine ausreichende Benetzung mit dem Material der unteren Deckschicht 10' und der oberen Deckschicht 14' eingeht, und daher werden die Öffnungen 15 der oberen Deckschicht 14' von unten dicht verschlossen. Dadurch lässt sich eine vorbestimmte Atmosphäre und ein vorbestimmter Druck unter der Verkappung einstellen. Beim Öffnen der Heizvorrichtung muss allerdings abgewartet werden, bis die Temperatur unter die Schmelztemperatur des Materials der zweiten Verschlusschicht 20 gesunken ist.

Zur dauerhaften hermetischen Verschließung kann optionalerweise eine weitere Verschlusschicht 25 über der resultierenden Struktur wie beider ersten Ausführungsform abgeschlossen werden, wie in Fig. 2e gezeigt.

Fig. 3a-c sind eine schematische Querschnittsansicht der Herstellungsstufen eines mikromechanischen Bauelements gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Bei der dritten Ausführungsform wird das Material der oberen Deckschicht 14" derart gewählt, dass es einen niedrigeren Schmelzpunkt als das Material der unteren Deckschicht 10" aufweist. Beispielsweise kann das Material der oberen Deckschicht 14" Aluminium sein, welches bei 660°C aufschmilzt, während das Material der unteren Deckschicht 10" ein hochschmelzendes Material, z. B. CVD-Silizium, ist.

Fig. 3a zeigt den Zustand nach dem Opferschicht-Ätzen entsprechend dem Zustand von Fig. 2c bzw. dem Zustand von Fig. 1f.

Wie in Fig. 3b illustriert, wird nach dem Opferschicht-Ätzen und einer eventuell durchgeführten thermischen Reinigung der Oberflächen das Material der oberen Deckschicht 14" unter definierten Gas- und Druckbedingungen in einer Heizvorrichtung aufgeschmolzen. Bei einer ausreichenden Benetzung zwischen der unteren und oberen Deckschicht 10", 14" werden dann die Öffnungen 11 in der unteren Deckschicht 10" durch die obere Deckschicht 14" hermetisch dicht verschlossen.

Wie bei der zweiten Ausführungsform kann auch bei dieser dritten Ausführungsform zur hermetischen Versiegelung eine weitere Verschlusschicht 30 auf der oberen Deckschicht 14" aufgebracht werden, welche aus Siliziumdioxid, Aluminium, Siliziumnitrid, Silizium oder einem anderen geeigneten Material besteht. Dies zeigt Fig. 3c.

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar.

5 Es können insbesondere beliebige mikromechanische Grundmaterialien verwendet werden, und nicht nur das exemplarisch angeführte Siliziumsubstrat.

Auch können die Lochanordnungen und die Anzahl und das Design der Deckschichten und Opferschichten beliebig gewählt werden.

10 Weiterhin können die Strukturelemente der verschiedenen Ausführungsformen miteinander kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Mikromechanisches Bauelement mit: einem Substrat (1); einem auf dem Substrat (1) vorgeschobenen Funktionsbereich (5); und einer kappenförmigen Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14', 20, 25; 10", 14", 30) zum Abdecken des Funktionsbereichs (5); dadurch gekennzeichnet, daß die kappenförmige Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14', 20, 25; 10", 14", 30) mindestens eine obere und eine untere Deckschicht (10, 14; 10', 14'; 10", 14") aufweist; und die Deckschichten (10, 14; 10', 14'; 10", 14") eine jeweilige zueinander versetzte Lochanordnung (11, 15) aufweisen, von denen mindestens eine durch mindestens eine Verschlusschicht (17; 20, 25; 14", 30) verschlossen ist.

2. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Verschlusschicht (17; 25; 30) über der oberen Deckschicht (14; 14'; 14") angeordnet ist und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht (14; 14'; 14") durch die erste Verschlusschicht (17; 25; 30) verpfropft ist.

3. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Verschlusschicht (20) zwischen der oberen und der unteren Deckschicht (14', 10') angeordnet ist und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht (14') durch Schmelzperlen der zweiten Verschlusschicht (20) verschlossen ist.

4. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Deckschicht (14") als Verschlusschicht für die Lochanordnung (11) der unteren Deckschicht (10") fungiert.

5. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Deckschicht (14) Verbindungsstege zur Verbindung mit der unteren Deckschicht (10) aufweist.

6. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Deckschicht (10) und/oder die obere Deckschicht (14) Polysilizium oder Aluminium aufweist.

7. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlusschicht (17) Aluminium, Silizium, Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, ein Glas oder einen Lack aufweist.

8. Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Bauelementes nach Anspruch 1 mit den Schritten:

Vorsehen einer ersten Opferschicht (8) auf dem Funk-

tionsbereich (5);

Vorsehen der unteren Deckschicht (10; 10', 10'') mit der Lochanordnung (11) auf der ersten Opferschicht (8) derart, daß sie über den Rand der ersten Opferschicht (8) hinausgezogen ist und an der Peripherie des Funktionsbereiches (5) angebunden ist; 5

Vorsehen einer zweiten Opferschicht (12; 12') auf der unteren Deckschicht (10; 10', 10'');

Vorsehen der oberen Deckschicht (14; 14', 14'') mit der Lochanordnung (15) auf der zweiten Opferschicht (12; 10 12') derart, daß sie über den Rand der zweiten Opferschicht (12; 12') hinausgezogen ist und an der unteren Deckschicht (10; 10', 10'') und optionellerweise an der Peripherie des Funktionsbereiches (5) angebunden ist; 15 selektives Entfernen der ersten Opferschicht (8) und der zweiten Opferschicht (12; 12'); und

Verschließen mindestens einer der Lochanordnungen (11, 15) durch mindestens eine Verschlußschicht (17; 20, 25; 14'', 30).

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Verschlußschicht (17; 25; 30) über der oberen Deckschicht (14; 14', 14'') vorgesehen wird und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht (14; 14', 14'') durch die erste Verschlußschicht (17; 25; 30) verstopft wird, 25

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Verschlußschicht (20) auf der unteren Deckschicht (14', 10') vorgesehen wird und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht (14') durch Schmelzperlen der zweiten Verschluß- 30 schicht (20) verschlossen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Material der oberen Deckschicht (14'') derart gewählt wird, daß es einen niedrigeren Schmelzpunkt als das Material der unteren Deckschicht (10'') aufweist, dadurch gekenn- 35 zeichnet, daß die obere Deckschicht (14'') aufgeschmolzen wird, so daß sie die Lochanordnung (11) der unteren Deckschicht (10'') verschließt.

Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

FIG 1g

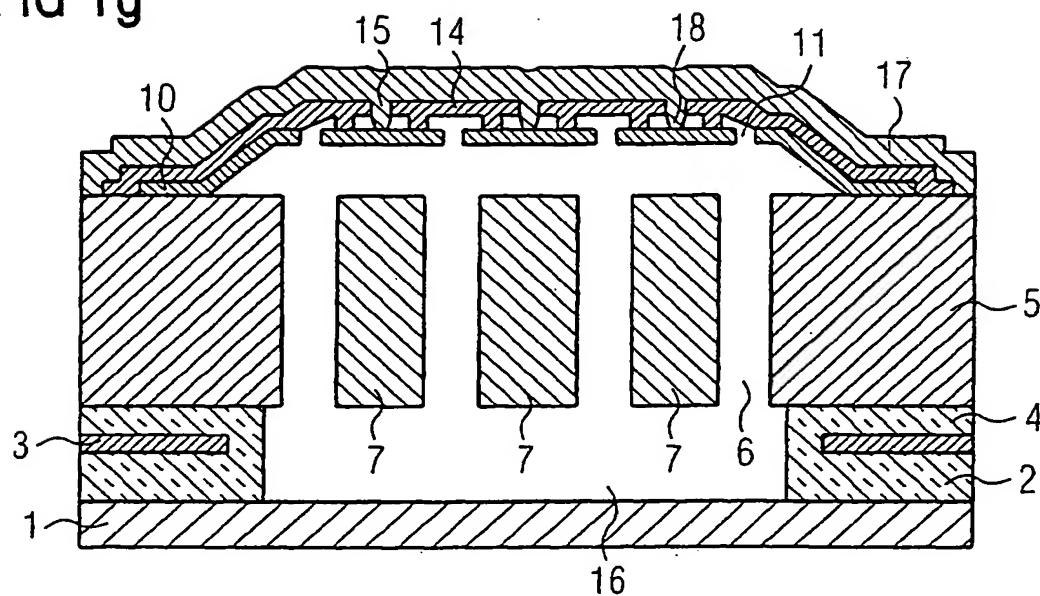


FIG 1h

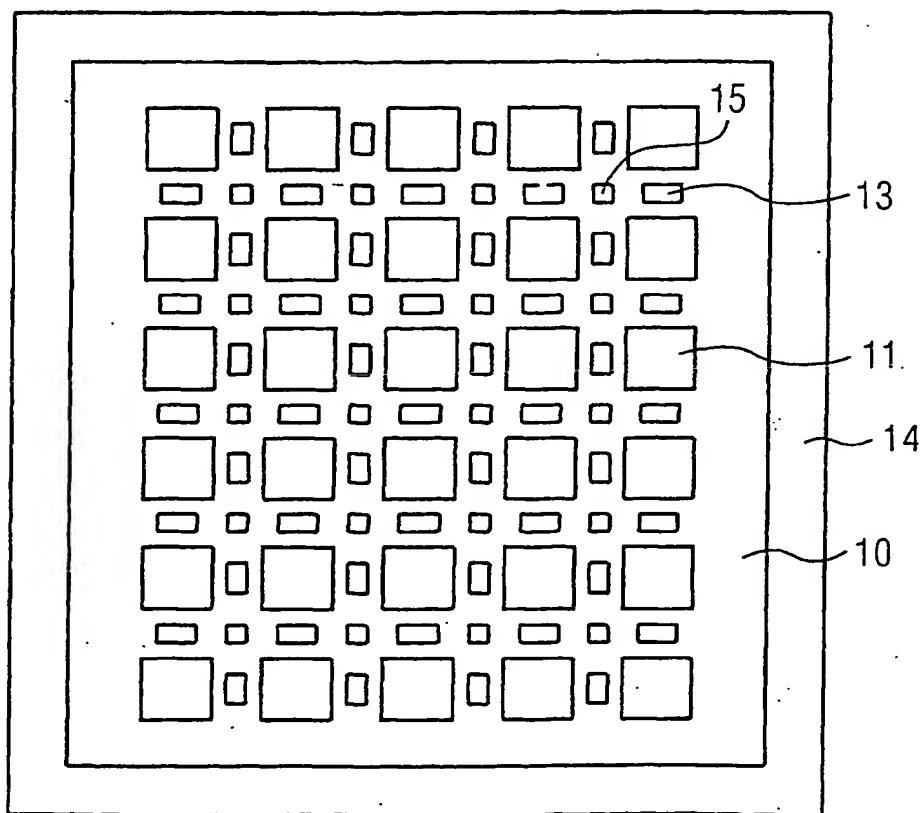


FIG 1a

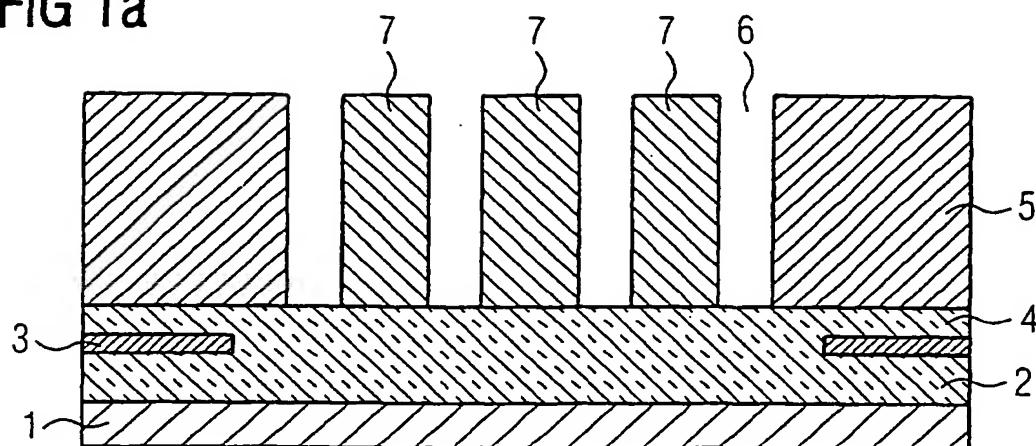


FIG 1b

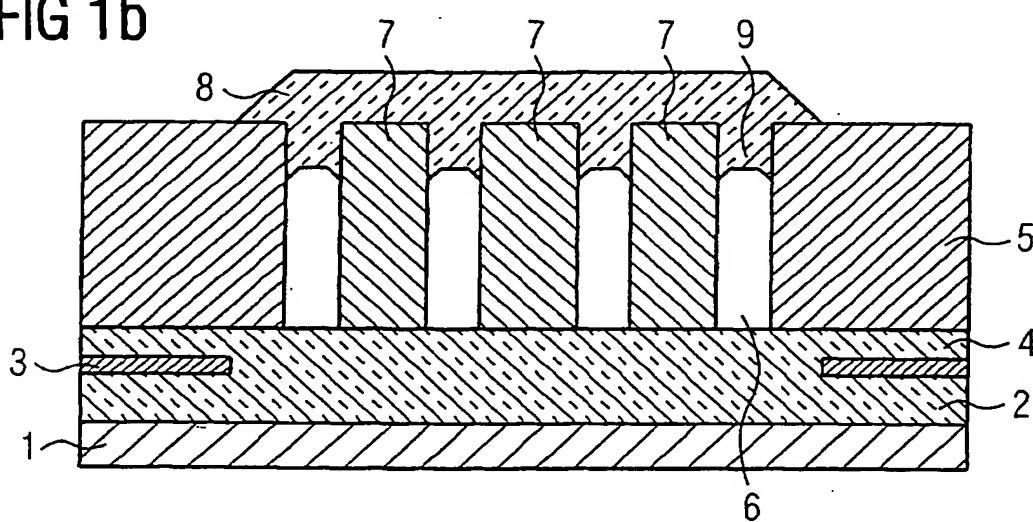


FIG 1c

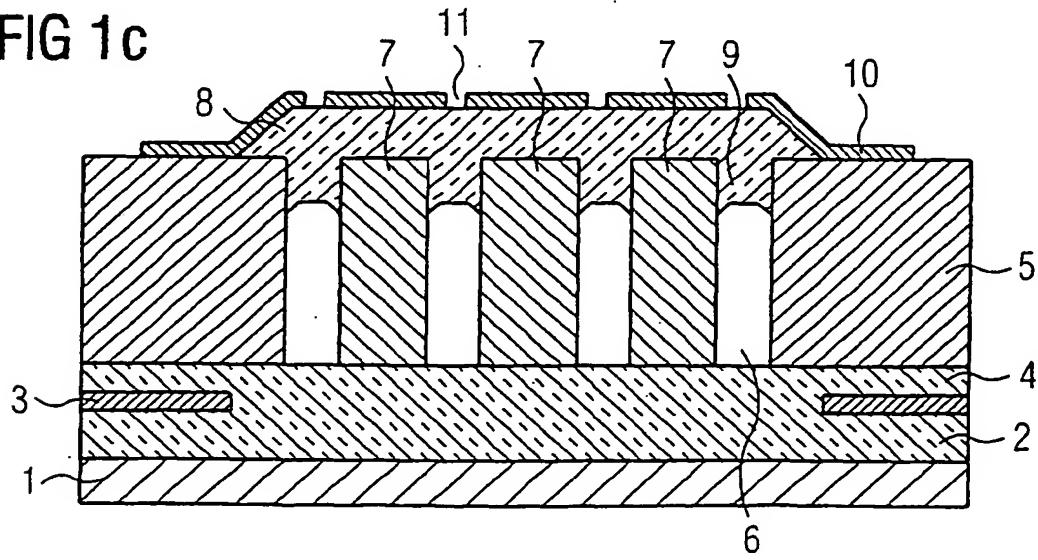


FIG 1d

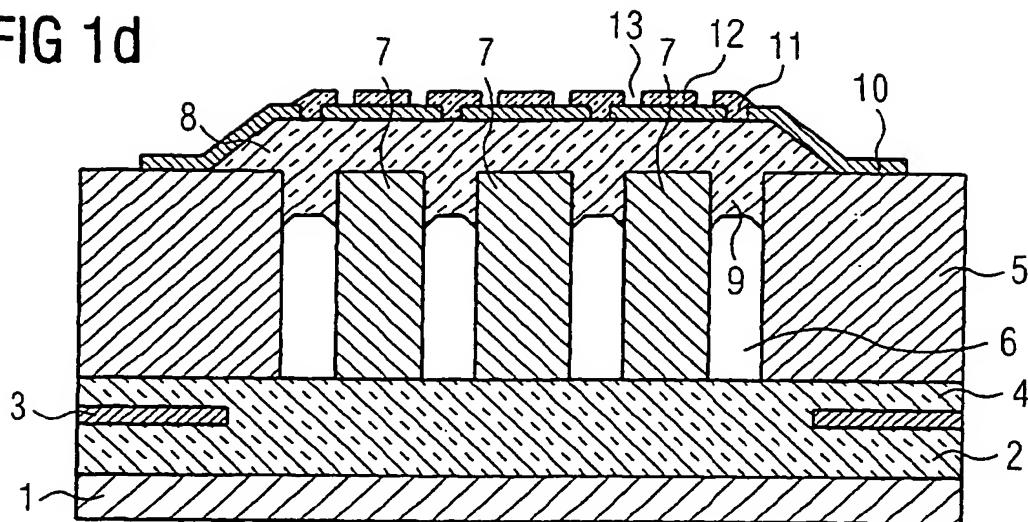


FIG 1e

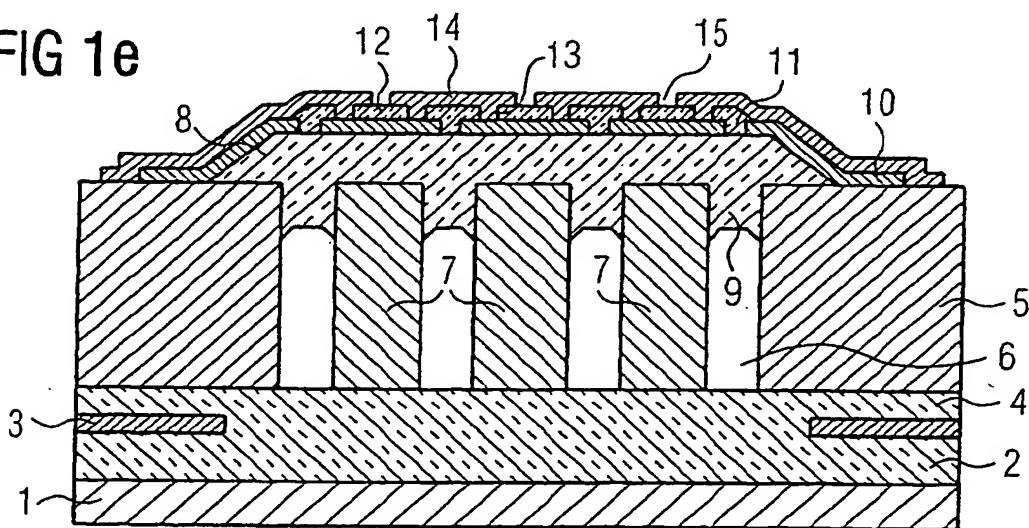


FIG 1f

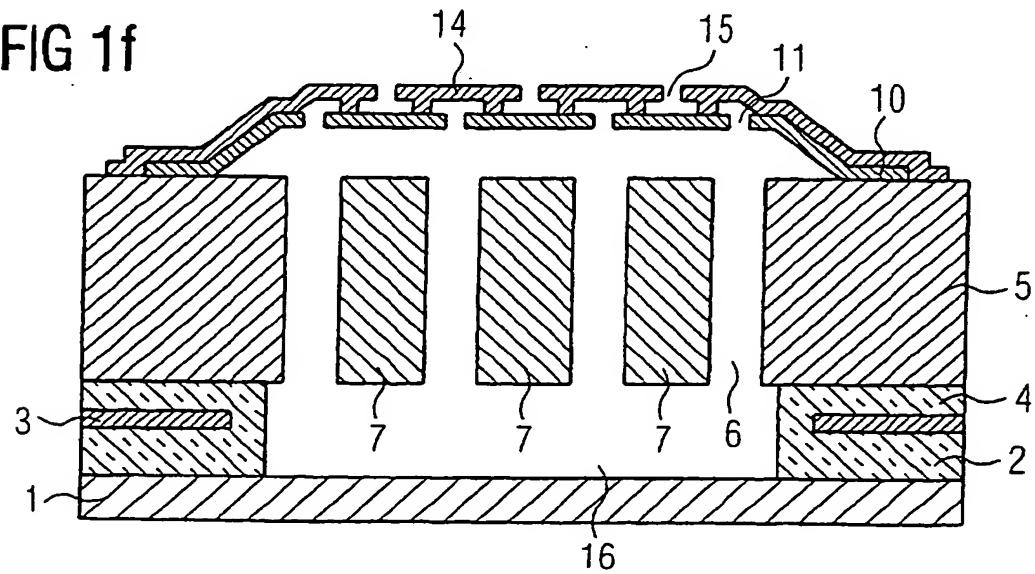


FIG 2a

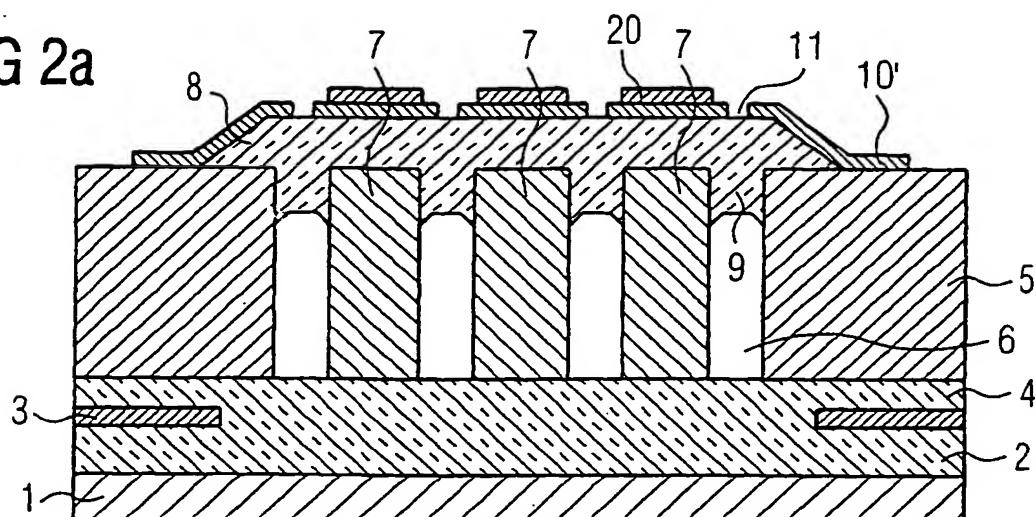


FIG 2b

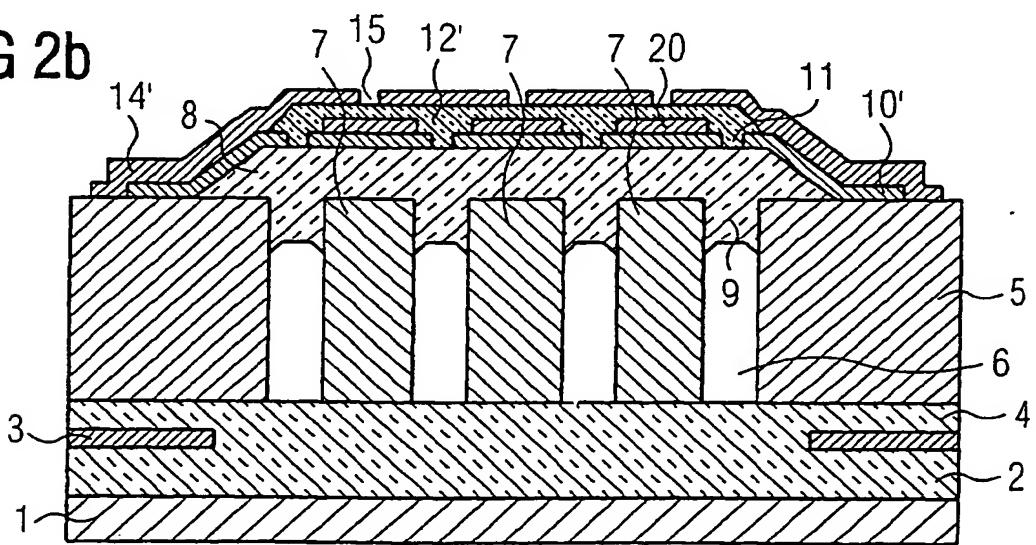


FIG 2c

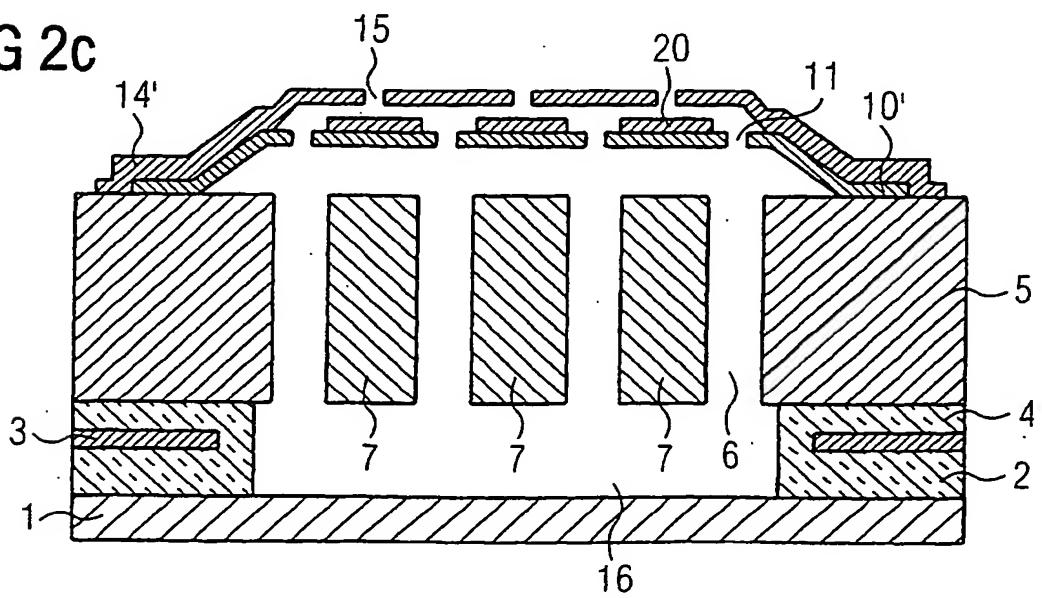


FIG 2d

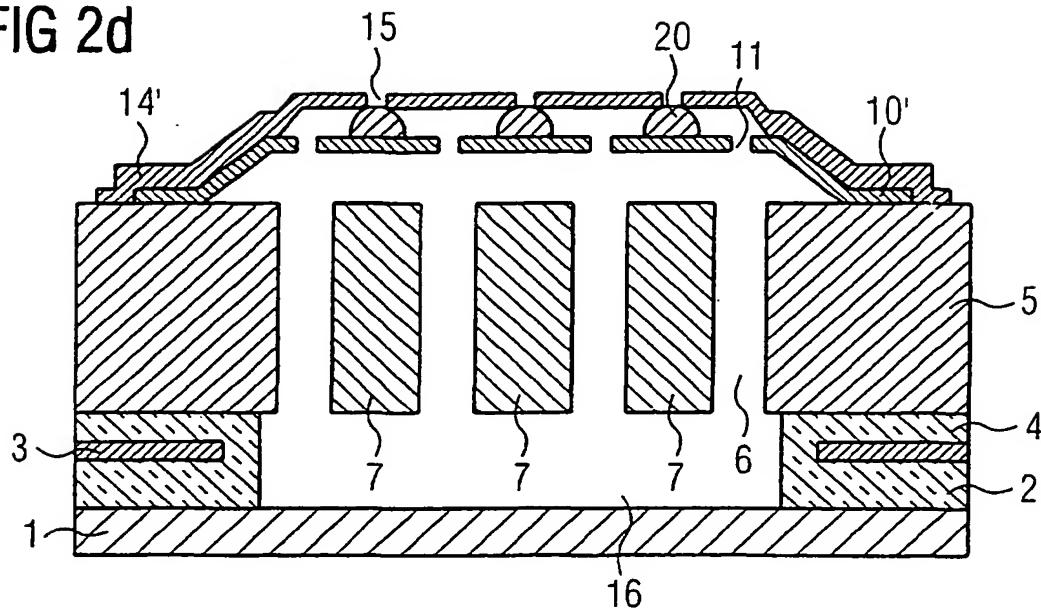


FIG 2e

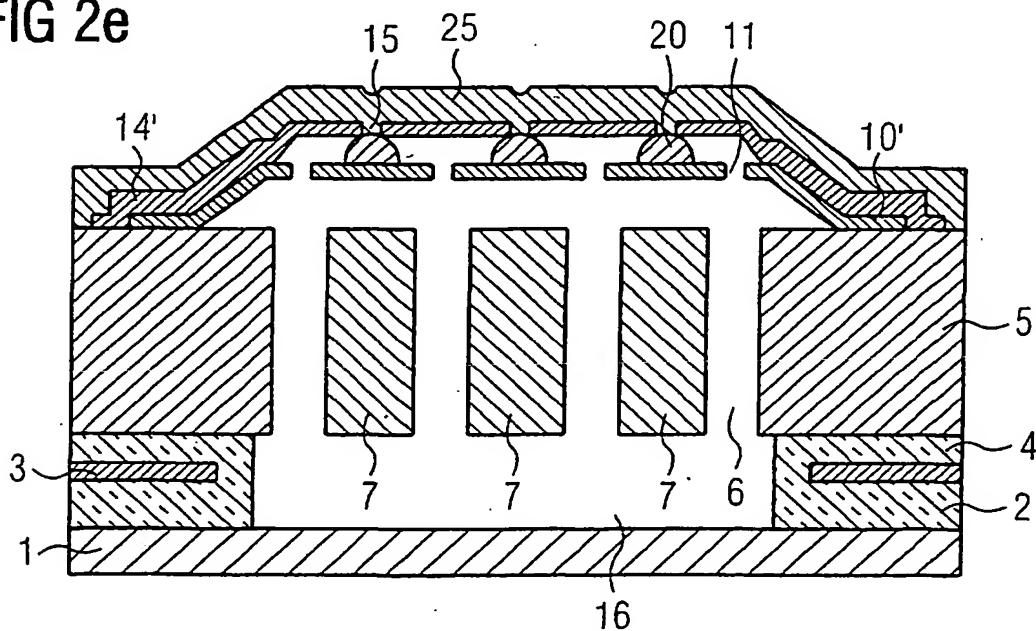


FIG 3a

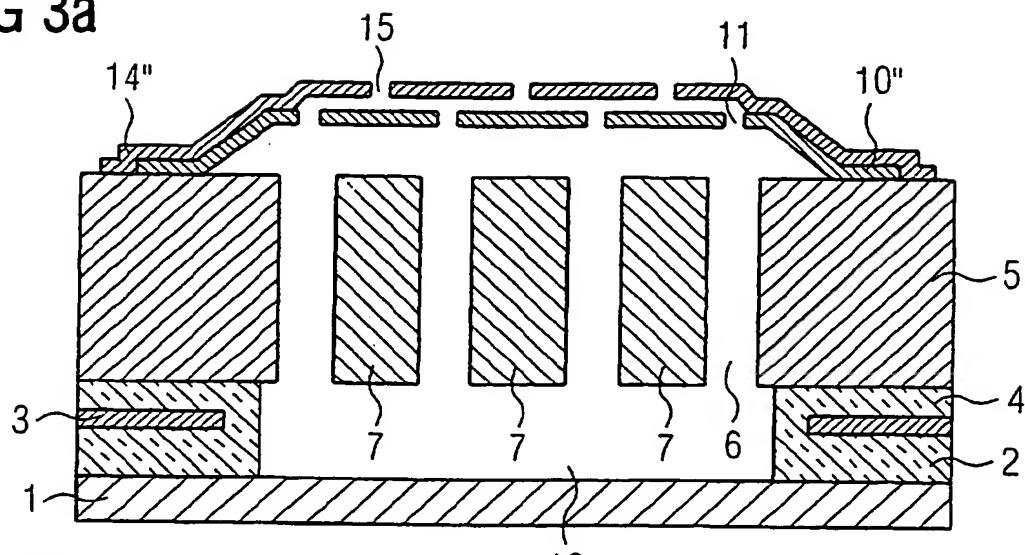


FIG 3b

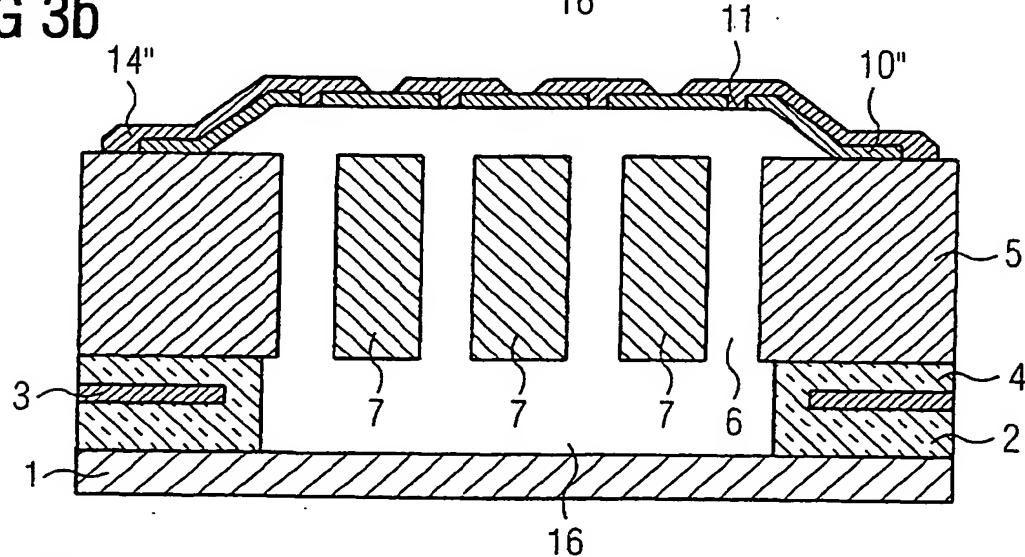


FIG 3c

